



	<h2 style="color: red;">FQD12P10TF</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQD12P10TF</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 100V 9.4A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD12P10TF.pdf 2.FQD12P10TF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 7555 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD12P10TF
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 100V 9.4A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	7555 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	TO-252, (D-Pak)
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 50W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.4A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	290 mOhm @ 4.7A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	27nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	800pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FQD12P10TF ist neu im Original, Suche FQD12P10TF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD12P10TF Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD12P10TF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD12P10 FAIRCHI FQD12P10 FAIRCHI</p>	 <p>FQD12N20TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A DPAK</p>	 <p>FQD12N20TM_F080 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A DPAK</p>	 <p>FQD12P10TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 9.4A DPAK</p>
 <p>FQD12P10TM-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 9.4A DPAK</p>	 <p>FQD12P10TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 9.4A DPAK</p>	 <p>FQD12N20TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A DPAK</p>	 <p>FQD12N20TM_F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQD10N20LTM	↔ FQD10N20LTM	⇒ FQD10N20TF	D FQD10N20TF	↔ FQD10N20TM
⊣ FQD10N20TM	⊗ FQD11P06	D FQD11P06-NL	⇒ FQD11P06TF	↔ FQD11P06TF
⊗ FQD11P06TM	⊣ FQD11P06TM	⊗ FQD12N10	↔ FQD12N20	↔ FQD12N20L
D FQD12N20LTF	⊗ FQD12N20LTF	⊣ FQD12N20LTM	⊗ FQD12N20LTM	↔ FQD12N20TF
⇒ FQD12N20TF	↔ FQD12N20TM	⊗ FQD12N20TM	⊣ FQD12P10	↔ FQD12P10TF
↔ FQD12P10TM	⇒ FQD12P10TM	D FQD13N06	⊗ FQD13N06L	⊣ FQD13N06LTF
⊗ FQD13N06LTF	D FQD13N06LTM	⇒ FQD13N06LTM	↔ FQD13N06LTM-NL	↔ FQD13N06TF
⊣ FQD13N06TF	⊗ FQD13N06TM	↔ FQD13N06TM	⇒ FQD13N10	↔ FQD13N10L
⊗ FQD13N10LTF	⊣ FQD13N10LTF	⊗ FQD13N10LTM	D FQD13N10LTM	↔ FQD13N10LTM-NL
↔ FQD13N10TM	⊗ FQD13N10TM	⊣ FQD13N20D	⊗ FQD14N15	↔ FQD16N15

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited